

製品概要

NTMFS4983NF: シングル Nチャンネル Power MOSFET 30V、106A、2.1mΩ

技術情報は、データシートをご参照ください。

Power MOSFET、30 V、106A、シングルNチャンネル、SO-8 FL

特長

- Integrated Schottky Diode
- Low rDS(on) to Minimize Conduction Loss
- Low Capacitance to Minimize Driver Losses
- Optimized Gate Charge to Minimize Switching Losses
- RoHS Compliant

アプリケーション

- CPU Power Delivery
- Synchronous Rectification for DC-DC Converters
- Low Side Switching
- Telecom Secondary Side Rectification

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS(s)}$ Min (V)	V_{GS} Max (V)	$V_{GS(th)}$ Max (V)	I_D Max (A)	P_D Max (W)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5V$ (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5V$ (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 10V$ (mΩ)	Q_g Typ @ $V_{GS} = 4.5V$ (nC)	Q_g Typ @ $V_{GS} = 10V$ (nC)	C_{iss} Typ (pF)	Package Type
NTMFS4983NFT1G	0.4652	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	N-Channel	Single	30	20	2.3	106	3.13	-	3.1	2.1	25	22.6	3250	SO-8FL / DFN-5
NTMFS4983NFT3G	0.4009	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	N-Channel	Single	30	20	2.3	106	3.13	-	3.1	2.1	25	22.6	3250	SO-8FL / DFN-5

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

6/22/2021 作成